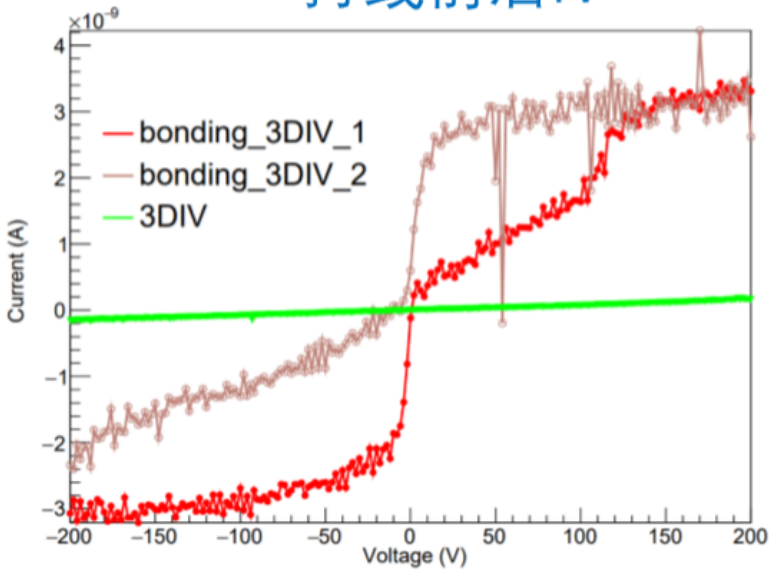
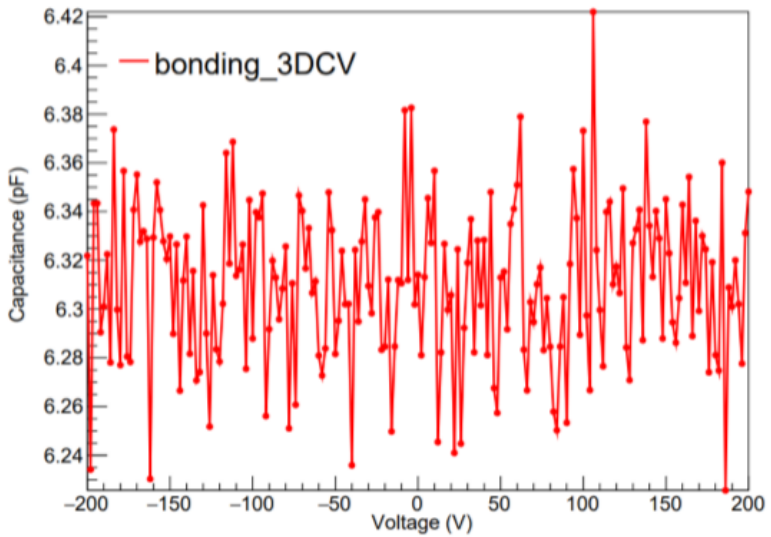
打线IV，CV测试：

打线前后IV

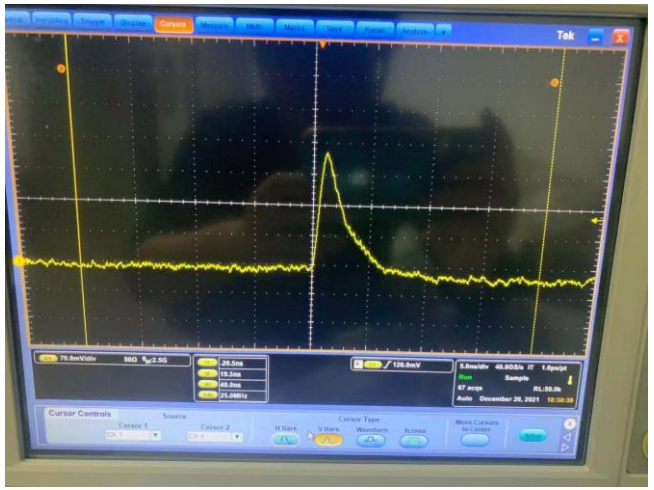


打线后CV

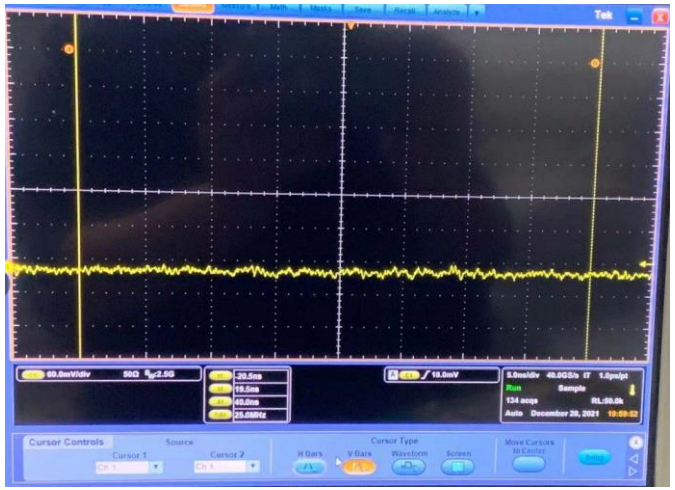


- 打线后两此次IV测试，表明电极是连通的
- 与探针台测试结果相比，电流更大，且形状差异很大 （未知原因）
- 打线后CV测试结果依旧比较奇怪，可能是测试参数不对

3D 芯片^{241}Am 测试：



100um PN结 SiC： 信号 260mV



350um 3D-SiC： 无信号

- 3D-SiC：-600V时，漏电流为0.01276uA。 0V时，漏电流为0.00029uA. 连接导通
- 350um SiC应该有更高的信号
- 无信号可能原因：1. 耗尽的太少 2.缺陷太多 3.只是表面导通等
- 现在的结构应该是无法测alpha粒子响应的
  - 高能领域里面，很少用肖特基芯片测电子响应
  - 是否需要考虑如何制作PN结类型的3D芯片